

用途: 高电压控制电路。

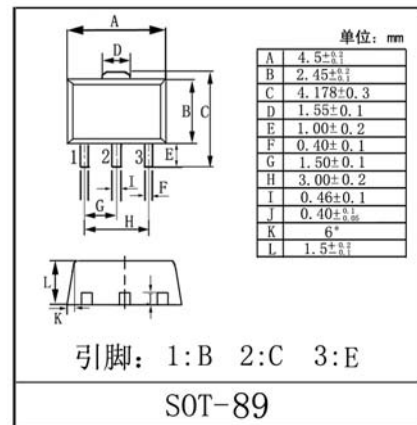
Purpose: High voltage control circuit.

特点: 耐压高, 饱和压降低, 集电极输出电容低, 与 MMBTA42T (3DG42TM) 互补。

Features: High voltage, low saturation voltage, low collector output capacitance, complementary pair with MMBTA42T (3DG42TM).

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-300	V
V_{CE0}	-300	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-500	mA
P_C	500	mW
T_j	150	°C
T_{stg}	-55~150	°C



电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C = -100 \mu A$ $I_E = 0$	-300			V
V_{CE0}	$I_C = -1.0mA$ $I_B = 0$	-300			V
V_{EB0}	$I_E = -100 \mu A$ $I_C = 0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB} = -200V$ $I_E = 0$			-0.25	μA
I_{EB0}	$V_{BE} = -3.0V$ $I_C = 0$			-0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -10V$ $I_C = -10mA$	40			
$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -10V$ $I_C = -30mA$	25			
$h_{FE(3)}$	$V_{CE} = -10V$ $I_C = -1.0mA$	25			
$V_{CE(sat)}$	$I_C = -20mA$ $I_B = -2.0mA$			-0.5	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C = -20mA$ $I_B = -2.0mA$			-0.9	V
f_T	$V_{CE} = -20V$ $I_C = -10mA$ $f = 100MHz$	50			MHz
C_{cb}	$V_{CB} = -20V$ $I_E = 0$ $f = 1.0MHz$			6.0	pF

印章/Marking:H2D*

MMBTA92T (3CG92TM)

